102380 EUROPEAN PATENT OFFICE
LITERATUR NOPIEEN

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

53135276

PUBLICATION DATE

25-11-78

APPLICATION DATE

30-04-77

APPLICATION NUMBER

52050423

APPLICANT:

MITSUBISHI ELECTRIC CORP;

INVENTOR:

NISHIOKA SUNAO;

INT.CL.

H01L 21/302

TITLE

CORRECTING METHOD FOR DEFECT OF PHOTOMASK

ABSTRACT :

PURPOSE: To correct defects by irradiating electron beam to the photomask light

transmission part in the atmosphere where organic compound vapour exists.

COPYRIGHT: (C)1978,JPO&Japio

				τ
				· ,
				,
			-	
			,	
	,	. •		
,				
	. •			
	•			
		•		
		· .		

19日本国特許庁

公開特許公報

①特許出願公開

昭53-135276

(1) Int. Cl.²
H 01 L 21/302

識別記号

砂日本分類 99(5) C 3 庁内整理番号 7113-57 砂公開 昭和53年(1978)11月25日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全3 頁)

匈ホトマスクの欠陥修正法

顧 昭52-50423

②出 願

@特

1 昭52(1977)4月30日

⑫発 明 者 西岡直

伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三菱

⑪出 願 人 三菱電機株式会社

内

東京都千代田区丸の内二丁目 2

電機株式会社LSI開発センタ

番3号

砂代 理 人 弁理士 葛野信一

外1名

BH 20: 48

1 発明の名称

ホトマスクの欠陥修正法

2. 特許請求の範囲

(1) 有機化合物蒸気の存在する客曲気内で電子ビームをホトマスクの欠陥個所に照射し、前記欠陥個所にカーボン膜を形成することを特徴とするホトマスクの欠陥修正法。

(2) 有按化合物蒸気が真空ポンプ油蒸気である前記特許請求の範囲第1項記載のホトマスクの欠陥 修正法。

(3) 彰子ビームが所要のパターンで走査できる亀子ビームであり、カーボン股が粒子ビームの走査に対応した形状のカーボン膜である前記特許論求の範囲第1項記載のホトマスクの欠陥修正法。

8. 発明の詳細な説明

この発明け、半導体装置の製造に用いられるホトマスクの欠陥修正法に係る。

近年の半海体製量の製造においては、 写真食刻 技術が広く適用され、 この写真食刻技術にはホト

ホトマスクは通常、ガラス板のごとき選光性支持体の上にクロム膜のごとき遅光性級が遮光部としてパターン状に配置されており、 遠光 妊娠のない部分は選光部となつている。 そしてこう したホトマスクの欠陥の修正は、従来、不必勢な基光部

特閱昭53-135276(2)

の欠陥修正は比較的容易であつても、 不必要な逃 光部の欠陥修正はきわめて困難であった。

従来、ホトマスクの不必要な遮光配の欠陥修正 には、不必要を避光性膜たとえば不必要をクロム 股の残存に対しては、レーザ光照射による不必要 カクロム膜のトリミングで除去するなどの欠陥修 正法があり比較的容易であつた。しかし避光性胀 のピンホール、遮光性膜パターンの欠除など透光 部の欠陥修正には、新らたに進光性脱をピンホー ルヤパターン欠除の個所に充填・附加しなければ ならないため欠陥修正が困難であつた。すなわち 新らたに遮光性膜を充填・附加する影光部の欠陥 修正法として、欠陥ホトマスクへ更に遮光性版を 全面または欠陥個所を含む領域に形成し、これに 欠陥修正のための写真食刻技術を適用する方法が あるが、との従来の欠陥修正法は剃らたに別の欠 脈を発生させる欠点があり、修正作業の繁雑な欠 点があつた。

本発明によるホトマスクの欠陥修正法は、有格化合物蒸気の存在する労闘気の中で電子ビームを

(9)

したようなピンホール(8)、パターン欠除(4)などで ある。 ザ子ピーム発生源(7)には、図示されていな いが電子ビーム(8)の射出を停止できるカツトオフ 質値が含まれており、かつホトマスク(100)面上 の欠陥個所的のみ電子ビーム目が射突できるよ うな個向電板が含まれており、またこれら電極を 慰動できる貧気回路が合まれている。これら電子 ビーム発生源(7)け、走査型電子顕微鏡における電 子ピーム発生施と略々同じものである。第2図目 け欠陥循所(8)のみに筒子ピーム(8)が照射されてい る状態を示している。ととろで電子ピーム(8)が有 想化合物蒸気切の中を通過するとき、有機化合物 蒸気(5)の種類、蒸気圧、電子ビーム(8)の加速電圧、 ビーム電流密度、照射時間が適切であれば、有数 化合物蒸気(5)の分子は電子ビーム(8)でカーボンと その他の気体に分解され、そのうちカーボンは電 子ピーム(8)の射矢している欠陥個所(8)に推秘・固 私し、カーボン膜(8)が形成される。とのカーボン 膜(1)の腹厚は、たとえば電子ビーム(1)の照射時間 を調節することにより、遮光性脹(2)の膜厚と略々

照射することによつて、従来のホトマスクの欠陥 修正法の欠点、とくに上記の選光別の欠陥修正法 の欠点を除去しようとするものである。

以下図面にしたがつて、この発明を許しく説明 する。第1回は、透光部の欠陥を有するホトマス クの部分平面図、第2回は本発明によるホトマス クの欠陥修正法を説明するための断面図である。

第1図においては、ガラス板のととき透光性支持体(1)の上にクロム酸のととき遮光性膜(2)のパターンを有するホトマスク(100)に、遮光性膜のピンホール(5)とパターン欠除(4)の代表的な遊光配の欠陥が示されている。無欠陥ホトマスクとしてはピンホール(3)が遮光性膜で充填され、パターン欠除(4)が斜線を施した部分に遮光性层が存置されるべきものである。

本発明による欠陥修正法では、第2図回に示す ととく、ホトマスク(100)が有核化合物無数(5)の 中に配置されており、進光性膜を充泉・附加すべ き欠陥値所(6)に対向する位置に電子ビーム発生源 (7)が配過されている。欠陥値所(6)とは第1 座で示

(4)

等しくできる。カーボン膜(0)の光透過率は、カーボン膜(0)の膜厚がたとえば遮光性膜(2)としてのクロム膜と同じ膜厚の800Åもあれば、写真動用光源の光波長に対してほとんど等(ゼロ)である。したがつてカーボン膜(0)は遮光性膜としての楔能を果すこととかる。この結果、欠陥個には1、ホトマスク(100)は無欠陥ホトマスクに修正される。

パターン欠除(4)のどとき欠陥に対しては、電子ビーム発生頭(7)の諸電極を駆動させパターン欠除(4)の個所にのみ電子ビーム(8)が射突するようにすればよい。

有機化合物熱気(5)としては、たとえば真空ポンプ油の蒸気を用い、その蒸気圧を 10⁻⁴ Torr 代調整し、その蒸気圧の調整は電子ビーム発生源(7)を合む真空容器内に設けた真空ポンプ油の温度 コントロールによればよい。

欠陥修正後のホトマスク (100) にけ、有機化合物分子が付着することもあり得るがきわめて海い

(6)

特開昭53-135276(3)

分子膜であるゆえ、迎常のホトマスクの洗浄処理 ルよつて除去できる。

4. 図面の触単を説明

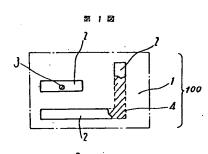
第1図は透光部の欠陥を有するホトマスクの部分平面図、第2図は本発明によるホトマスクの欠陥修正法を説明するための断面図である。(1)は透光性支持体、(2)は選光性版、(3)はピンホール、(4)

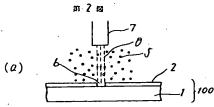
(7)

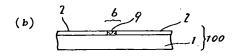
はパターン欠除、(5) は有機化合物蒸気、(0) は欠陥 個所、(7) は電子ビーム発生源、(8) は電子ビーム、 (8) はカーボン膜、(100) はホトマスクである。

代理人 葛 野 信 一

(8)







Docket # 10 | D | L | L | 29 |
Applic. # 10 | D | L | L | 29 |
Applicant: Chr. Start Sch. | 2 | et al. |

Lerner and Greenberg, P.A.

Post Office Box 2480

Hollywood, FL 33022-2480

Hollywood, FL 33022-2480

Tel: (954) 925-1100 Fax: (954) 925-1101